

# プロセスエンジニアのための分析応用セミナー

～ わかりやすいデータ解説と新技術紹介～

	時間	プログラム
1	10:00-10:20	EAGの紹介
2	10:20-11:20	<b>世界一の規模を誇るEAGのSIMS分析ラボについて</b> シリコンバレーでSIMS装置1台からスタートしたEAGのユニークな分析技術とデータを解釈するときの間違えやすいポイントを解説
3	11:20-12:10	<b>Expanding the application of SIMS - SIMS quantifications in different oxides and metals</b> SIMS定量分野の酸化物および金属材料への適用拡大 <b>【新技術紹介】</b>
12:10-13:00		お昼休憩（お弁当、お飲み物をご用意しております）
4	13:00-14:00	<b>特別講演 // 法政大学客員教授 中村 徹</b> <b>GaNへのイオン注入とデバイス試作</b> GaNはイオン注入による自由な導電型領域形成が困難とされていた。 最近開発したGaNへのp型層形成法と本技術を応用したデバイス特性について解説。
5	14:00-15:00	<b>Ⅲ-Vデバイスの故障解析とHR-STEMによる評価事例</b> 前半は、発光デバイスに関するTEMの故障解析事例を、 後半は、HR-STEMを用いた最新の分析事例の紹介。 <b>【新技術紹介】</b>
15:00-15:20		ブレイク（お飲み物、お茶菓子をご用意しております）
6	15:20-15:50	<b>Mgイオン注入GaN試料の結晶性評価</b> GaN基板中に注入条件を変え、Mgイオン注入された試料のアニール前後における結晶性の変化やMgプロファイルの変化を、RBS、SIMS及びTEMを用いて評価した事例の紹介。
7	15:50-16:40	<b>SEMによる電子デバイス材料評価のポイント</b> SEMでは形態観察以外にEDS、EBSD、EBIC、CLなど様々な測定が可能である。 電子材料をこれらの手法で評価した事例を紹介。

※誠に申し訳ございませんが同業の方のお申込みはご遠慮頂いております。

※プログラムが変更となる場合もございますのでご了承くださいませ。

各プログラム後に質疑応答の時間をもうけております。

分析に関する質問はいつでも受付ておりますのでanalysis@eag.comまたは03-5396-0531まで